

Таким образом, в этом случае электропроводность неограниченно убывает ( $\sim H^{-2}$ ) и, как это на первый взгляд ни парадоксально, обратно пропорциональна времени релаксации.

В действительности в этом нет ничего удивительного, так как ток вдоль оси  $y$  в этом случае возникает только в результате столкновений.

## 7.5. ТЕРМОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Рассмотрим примесный полупроводниковый образец, вдоль которого существует перепад температур (пока в отсутствие магнитного поля). Концентрация и скорости электронов на горячем конце больше, чем на холодном; поэтому поток электронов от горячего конца к холодному  $j_{гор}$  больше, чем в обратном направлении  $j_{хол}$ , в результате чего возникает поле термо-э. д. с., тормозящее горячие электроны, ускоряющее холодные и уравнивающее эти потоки. Таким образом, в стационарном состоянии в разомкнутой цепи благодаря термо-э. д. с.

$$j_{гор} = j_{хол} = j_0. \quad (7.109)$$

Уменьшая энергию и поток горячих электронов и увеличивая энергию и поток холодных электронов, термо-э. д. с. уменьшает теплопроводность электронного газа [16], но, разумеется, не обращает ее в нуль — это противоречило бы второму началу термодинамики.

Таким образом, энергия электронов, идущих от горячего конца, остается больше и поток тепла вдоль образца будет равен

$$Q = \frac{1}{e} (j_{гор} \bar{\epsilon}_{гор} - j_{хол} \bar{\epsilon}_{хол}) = \frac{j_0}{e} (\bar{\epsilon}_{гор} - \bar{\epsilon}_{хол}) > 0. \quad (7.110)$$

Посмотрим теперь, что произойдет, если мы включим магнитное поле. Тогда электроны, движущиеся от горячего конца, будут отклоняться на одну боковую грань, и она будет нагреваться, а электроны, движущиеся от холодного конца, будут отклоняться на противоположную грань, и она будет охлаждаться. Это явление носит название эффекта Риги — Ледюка. Теория дает следующее выражение для поперечного градиента температуры в примесном невырожденном полупроводнике при простой

параболической зонной структуре:

$$\frac{\partial T}{\partial y} = \frac{\left(\frac{2r+1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2}}{r+2} \frac{\kappa_{эл}}{\kappa_p + \kappa_{эл}} R_x \sigma \frac{\partial T}{\partial x}. \quad (7.111)$$

Как видно из (7.111), даже в этом простейшем случае выражение для поперечной разности температур весьма сложно. Поэтому, а также из-за трудности тепловых измерений исследования эффекта Риги — Ледюка не нашли широкого применения.

Перейдем теперь ко второму поперечному эффекту, так называемому эффекту Нернста — Эттингсгаузена, имеющему сейчас весьма большое значение в исследовании и применении полупроводников.

Как мы уже упоминали, потоки горячих и холодных электронов  $\bar{j}_{гор}$  и  $\bar{j}_{хол}$  одинаковы, но средние энергии в потоке  $\bar{\epsilon}_{гор}$  и  $\bar{\epsilon}_{хол}$  различны. Следовательно, горячие и холодные электроны будут отклоняться магнитным полем на разные углы, в результате чего в образце возникнет поперечный ток

$$j'_y = j_{гор} \bar{\Phi}_{гор} - j_{хол} \bar{\Phi}_{хол} = \frac{j_0}{T} [\tau(\bar{\epsilon}_{гор}) - \tau(\bar{\epsilon}_{хол})] \quad (7.112) *$$

и поперечная разность потенциалов  $E_y$ , которая будет возрастать до тех пор, пока обусловленный этой разностью потенциалов ток  $j''_y = \sigma E_y$  не скомпенсирует  $j'_y$ .

Для простейшего случая, рассмотренного выше (примесный невырожденный полупроводник, простая зонная структура), выражение для поперечной э. д. с. Нернста — Эттингсгаузена имеет вид

$$E_y = \frac{2r-1}{2} \frac{A(r)}{e} \frac{k}{c} u H \frac{\partial T}{\partial x}, \quad (7.113)$$

где  $A(r)$  — коэффициент, входящий в выражение для постоянной Холла.

Как видно из (7.113), эффект Нернста — Эттингсгаузена можно использовать для непосредственного измерения подвижности  $u$  (если известно  $r$ , или для определения  $r$ , если известно  $u$ ). Его преимущество перед эффектом Холла заключается в том, что в последнем случае мы получаем подвижность косвенно через постоянную Холла и электро-

\* Из (7.112) видно, что если время релаксации не зависит от энергии, то поперечная разность потенциалов не возникает.

проводность ( $u \approx R\sigma/A$ ), и если электропроводность оказывается заниженной за счет плохо проводящих прослоек между зернами поликристалла, то и для подвижности получаются неправильные значения. В эффекте Нернста — Эттингсгаузена значение прослоек значительно меньше.

В области собственной проводимости поперечная термо-э. д. с. Нернста — Эттингсгаузена приобретает значительно большие значения. Действительно, в этом случае поле термо-э. д. с. либо совсем не образуется, либо образуется лишь для того, чтобы выравнять потоки электронов и дырок, и после этого равные потоки электронов и дырок генерируются на горячем конце и рекомбинируют на холодном (см. гл. 6 — теплопроводность за счет биполярной диффузии).

Магнитное поле разворачивает эти потоки на противоположные грани образца, и на одной накапливается положительный заряд, а на другой — отрицательный.

Таким образом, в то время как в примесной проводимости э. д. с. Нернста — Эттингсгаузена возникала как эффект второго порядка за счет зависимости времени свободного пробега от энергии, здесь эта э. д. с. образуется всегда и достигает весьма больших значений. В этом случае выражение для э. д. с. Нернста — Эттингсгаузена примет вид

$$E_y = \frac{k}{2ec} \frac{A}{\sigma^2} \left[ (1 - 2r) (\sigma_n^2 u_n + \sigma_p^2 u_p) - \sigma_p \sigma_n (u_n + u_p) \left( 6r + 7 + \frac{2\Delta \mathcal{E}_0}{kT} \right) \right] H \frac{\partial T}{\partial x}. \quad (7.114)$$

Еще больших значений достигает э. д. с. Нернста — Эттингсгаузена в области смешанной проводимости, когда неосновные носители только появляются. Действительно, термо-э. д. с. в примесном полупроводнике уменьшает разность скоростей основных носителей на горячем и холодном конце и, наоборот, увеличивает эту разность для неосновных носителей, поэтому э. д. с. Нернста — Эттингсгаузена, создаваемая неосновными носителями, бывает очень велика.

В заключение этой главы приведем выражения для основных кинетических коэффициентов в слабом и нулевом магнитных полях, для одной параболической зоны (табл. 3 была любезно предоставлена нам В. И. Кайда-новым).

Выражения для основных кинетических коэффициентов в слабом и нулевом магнитном полях в полупроводниках со стандартной зоной и носителями одного типа

Название коэффициента и определение	Условие измерения	Формула	Коэффициенты, зависящие от степени вырождения и механизма рассеяния
Удельная электропроводность $\sigma_0 = j_x / E_x$	$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial y} =$ $= j_x = H_z = 0$	$\sigma_0 = \frac{2}{3} q^2 4\pi (2m^*)^{3/2} \tau_0 (k_0 T)^{r+1} A$ (3.1)	$A = (r+1) F_r$
Электронная составляющая коэффициента теплопроводности $\kappa_0^a = \left( W_x / \frac{\partial T}{\partial x} \right) - \chi^{\text{ф}}$	$i_x = i_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = H_z = 0$	$\kappa_0^a = \left( \frac{k_0}{e} \right)^2 T \sigma_0 L$ (3.2)	$L = \frac{r+3}{r+1} \frac{F_{r+2}}{F_r} - \frac{(r+2)^2}{(r+1)^2} \frac{F_{r+1}^2}{F_r^2}$
Коэффициент термоэ. д. с. $\alpha_0 = E_x / \frac{\partial T}{\partial x}$	$i_x = i_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = H_z = 0$	$\alpha_0 = \frac{k_0}{q} C$ (3.3)	$C = \frac{r+2}{r+1} \frac{F_{r+1}}{F_r} - \mu^*$
Постоянная Холла $R = E_y / (j_x H_z)$	$j_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$R = \frac{3}{2} \frac{\hbar^3}{4\pi (2m^*)^{3/2}} \frac{(k_0 T)^{-3/2}}{q} B$ (3.4)	$B = \frac{2r+1/2}{(r+1)^2} \frac{F_{2r-1/2}}{F_r^2}$
Коэффициент Эттингсгаузена $P = \left( -\frac{\partial T}{\partial y} \right) / (j_x H_z)$	$\frac{\partial T}{\partial x} = j_y =$ $= W_y = 0$	$P = \frac{k_0 T}{q} \frac{R \sigma_0}{\kappa_0} D$ (3.5)	$D = \frac{2r+3/2}{2r+1/2} \frac{F_{2r+1/2}}{F_{2r-1/2}} \frac{r+2}{r+1} \frac{F_{r+1}}{F_r}$
Коэффициент поперечного эффекта Нернста-Эттингсгаузена $Q = E_y / \left( -\frac{\partial T}{\partial x} H_z \right)$	$i_x = i_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$Q = \frac{k_0}{q} R \sigma_0 D$ (3.6)	$G = \frac{1}{AL} \left\{ \frac{(2r+5/2)(r+1)}{2r+1/2} \times \right.$ $\times \frac{F_{2r+3/2} F_r}{F_{2r-1/2}} - 2 \frac{(r+2)(2r+3/2)}{2r+1/2} \times$ $\left. \times \frac{F_{2r+1/2} F_{r+1}}{F_{2r-1/2}} + \frac{(r+2)^2}{r+1} \frac{F_{r+1}^2}{F_r} \right\}$
Коэффициент Риги-Ледюка $S = -$ $-\frac{\partial T}{\partial y} / \left( -\frac{\partial T}{\partial x} H_z \right)$	$i_x = i_y = W_y = 0$	$S = -R \sigma_0 - \frac{\kappa_0^a}{\kappa_0} G$ (3.7)	

Выражения для основных кинетических коэффициентов в слабом и нулевом магнитном полях в полупроводниках со стандартной зоной и носителями одного типа

Название коэффициента и определение	Условие измерения	Формула	Коэффициенты, зависящие от степени вырождения и механизма рассеяния
Удельная электропроводность $\sigma_0 = j_x / E_x$	$\frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial y} =$ $= j_x = H_z = 0$	$\sigma_0 = \frac{2}{3} q^2 4\pi (2m^*)^{3/2} \tau_0 (k_0 T)^{r+1} A$ (3.1)	$A = (r+1) F_r$
Электронная составляющая коэффициента теплопроводности $\kappa_0^a = \left( W_x / \frac{\partial T}{\partial x} \right) - \chi^{\text{ф}}$	$i_x = i_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = H_z = 0$	$\kappa_0^a = \left( \frac{k_0}{e} \right)^2 T \sigma_0 L$ (3.2)	$L = \frac{r+3}{r+1} \frac{F_{r+2}}{F_r} - \frac{(r+2)^2}{(r+1)^2} \frac{F_{r+1}^2}{F_r^2}$
Коэффициент термоэ. д. с. $\alpha_0 = E_x / \frac{\partial T}{\partial x}$	$i_x = i_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = H_z = 0$	$\alpha_0 = \frac{k_0}{q} C$ (3.3)	$C = \frac{r+2}{r+1} \frac{F_{r+1}}{F_r} - \mu^*$
Постоянная Холла $R = E_y / (j_x H_z)$	$j_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$R = \frac{3}{2} \frac{\hbar^3}{4\pi (2m^*)^{3/2}} \frac{(k_0 T)^{-3/2}}{q} B$ (3.4)	$B = \frac{2r+1/2}{(r+1)^2} \frac{F_{2r-1/2}}{F_r^2}$
Коэффициент Эттингсгаузена $P = \left( -\frac{\partial T}{\partial y} \right) / (j_x H_z)$	$\frac{\partial T}{\partial x} = j_y =$ $= W_y = 0$	$P = \frac{k_0 T}{q} \frac{R \sigma_0}{\kappa_0} D$ (3.5)	$D = \frac{2r+3/2}{2r+1/2} \frac{F_{2r+1/2}}{F_{2r-1/2}} \frac{r+2}{r+1} \frac{F_{r+1}}{F_r}$
Коэффициент поперечного эффекта Нернста-Эттингсгаузена $Q = E_y / \left( -\frac{\partial T}{\partial x} H_z \right)$	$i_x = i_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$Q = \frac{k_0}{q} R \sigma_0 D$ (3.6)	$G = \frac{1}{AL} \left\{ \frac{(2r+5/2)(r+1)}{2r+1/2} \times \right.$ $\times \frac{F_{2r+3/2} F_r}{F_{2r-1/2}} - 2 \frac{(r+2)(2r+3/2)}{2r+1/2} \times$ $\left. \times \frac{F_{2r+1/2} F_{r+1}}{F_{2r-1/2}} + \frac{(r+2)^2}{r+1} \frac{F_{r+1}^2}{F_r} \right\}$
Коэффициент Риги-Ледюка $S = -\frac{\partial T}{\partial y} / \left( -\frac{\partial T}{\partial x} H_z \right)$	$i_x = i_y = W_y = 0$	$S = -R \sigma_0 - \frac{\kappa_0^a}{\kappa_0} G$ (3.7)	

Название коэффициента и определение	Условие измерения	Формула	Коэффициенты, зависящие от степени вырождения и механизма рассеяния
Магнетосопротивление $\frac{\Delta\rho(H)}{\rho_0} = \sigma_0 \left( \frac{1}{\sigma(H)} - \frac{1}{\sigma_0} \right)$	$i_y = \frac{\partial T}{\partial x} = \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$\frac{\Delta\rho}{\rho_0 H_z^2} = (R\sigma_0)^2 M \quad (3.8)$	$M = \frac{3r(r+1)}{(2r+1/2)^2} \frac{F_{3r-1} F_r}{F_{2r-1/2}^2} - 1$
Магнитотермо-э. д. с. $\frac{\Delta\alpha(H)}{\alpha_0} = \frac{\alpha(H) - \alpha_0}{\alpha_0}$	$i_x = i_y = \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$\frac{\Delta\alpha}{\alpha_0 H_z^2} = (R\sigma_0) \frac{N}{C} \quad (3.9)$	$N = D - M + \frac{(r+2)3r}{(2r+1/2)^2} \frac{F_{3r-1} F_{r+1}}{F_{2r-1/2}^2} + 1$
Относительное изменение теплопроводности в магнитном поле $\frac{\Delta\kappa(H)}{\kappa_0} = \frac{\kappa^s(H) - \kappa_0^s}{\kappa_0^s + \kappa^\Phi}$	$i_x = i_y = \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$\frac{\Delta\kappa(H)}{\kappa_0 H_z^2} = \left( \frac{k_0}{e} \right)^2 \frac{\sigma_0 T}{\kappa_0} (R\sigma_0)^2 (D^2 - V) \quad (3.10)$	$V = \frac{(3r+2)(r+1)}{(2r+1/2)^2} \frac{F_{3r+1} F_r}{F_{2r-1/2}^2} - 2 \frac{(3r+1)(r+2)}{(2r+1/2)^2} \frac{F_{3r} F_{r+1}}{F_{2r-1/2}^2} +$
	$i_x = i_y = W_y = 0$	$\frac{\Delta\kappa(H)}{\kappa_0 H_z^2} = \left( \frac{k_0}{e} \right)^2 \frac{\sigma_0 T}{\kappa_0} (R\sigma_0) \times \left[ D^2 - V + \left( \frac{k_0}{e} \right)^2 \frac{\sigma_0 T}{\kappa_0} G^2 \right] \quad (3.11)$	$+ \frac{3r(r+2)^2}{(2r+1/2)^2 (r+1)} \frac{F_{3r-1} F_{r+1}^2}{F_{2r-1/2}^2 F_r}$

Обозначения:  $k_0$  — постоянная Больцмана;  $q$  — заряд носителя тока;  $H$  — напряженность магнитного поля;  $E$  — напряженность электрического поля;  $j$  — плотность тока;

$$F_n \equiv F_0(\mu^*) \equiv \int_0^\infty \frac{x^n}{1 + e^{x - \mu^*}} dx \text{ — интеграл Ферми;}$$

$\mu^*$  — приведенный уровень химического потенциала;  $W$  — плотность потока энергии.

Примечание. Образцы имеют форму прямоугольных параллелепипедов;  $H$  направлено по оси  $z$ ;  $E, \nabla T$  — в плоскости  $(x, y)$ .

Название коэффициента и определение	Условие измерения	Формула	Коэффициенты, зависящие от степени вырождения и механизма рассеяния
Магнетосопротивление	$i_y = \frac{\partial T}{\partial x} =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$\frac{\Delta \rho}{\rho_0 H_z^2} = (R\sigma_0)^2 M \quad (3.8)$	$M = \frac{3r(r+1)}{(2r+1/2)^2} \frac{F_{3r-1} F_r}{F_{2r-1/2}^2} - 1$
Магнитотермо-э. д. с.	$i_x = i_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$\frac{\Delta \alpha}{\alpha_0 H_z^2} = (R\sigma_0) \frac{N}{C} \quad (3.9)$	$N = D - M + \frac{(r+2)3r}{(2r+1/2)^2} \frac{F_{3r-1} F_{r+1}}{F_{2r-1/2}^2} + 1$
Относительное изменение теплопроводности в магнитном поле	$i_x = i_y =$ $= \frac{\partial T}{\partial y} = 0$	$\frac{\Delta \kappa(H)}{\kappa_0 H_z^2} =$ $= \left(\frac{k_0}{e}\right)^2 \frac{\sigma_0 T}{\kappa_0} (R\sigma_0)^2 (D^2 - V) \quad (3.10)$	$V = \frac{(3r+2)(r+1)}{(2r+1/2)^2} \frac{F_{3r+1} F_r}{F_{2r-1/2}^2} -$ $- 2 \frac{(3r+1)(r+2)}{(2r+1/2)^2} \frac{F_{3r} F_{r+1}}{F_{2r-1/2}^2} +$
	$i_x = i_y = W_y = 0$	$\frac{\Delta \kappa(H)}{\kappa_0 H_z^2} = \left(\frac{k_0}{e}\right)^2 \frac{\sigma_0 T}{\kappa_0} (R\sigma_0) \times$ $\times \left[ D^2 - V + \left(\frac{k_0}{e}\right)^2 \frac{\sigma_0 T}{\kappa_0} G^2 \right] \quad (3.11)$	$+ \frac{3r(r+2)^2}{(2r+1/2)^2 (r+1)} \frac{F_{3r-1} F_{r+1}^2}{F_{2r-1/2}^2 F_r}$

Обозначения:  $k_0$  — постоянная Больцмана;  $q$  — заряд носителя тока;  $H$  — напряженность магнитного поля;  $E$  — напряженность электрического поля;  $j$  — плотность тока;

$$F_n \equiv F_0(\mu^*) \equiv \int_0^{\infty} \frac{x^n}{1 + e^{x - \mu^*}} dx \text{ — интеграл Ферми;}$$

$\mu^*$  — приведенный уровень химического потенциала;  $W$  — плотность потока энергии.

Примечание. Образцы имеют форму прямоугольных параллелепипедов;  $H$  направлено по оси  $z$ ;  $E, \nabla T$  — в плоскости  $(x, y)$ .